



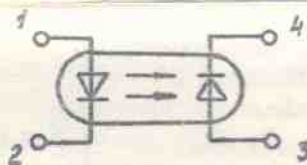
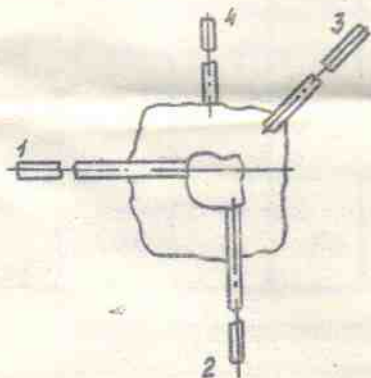
Светопары диодные  
типов АСД120 А-1, Б-1

Э Т И К Е Т К А

Бескорпусные диодные светопары типов АСД120 А-1, АСД120 Б-1, предназначенные для применения в составе гибридных оптроных микросхем аппаратуры широкого применения.

Схема расположения выводов

Схема электрическая  
принципиальная



Масса не более 0,1 г.

## ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

(при  $T_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ )

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		АОЛ20А-I		АОЛ20Б-I	
		не менее	не более	не менее	не более
Коэффициент передачи по току, % (при $I_{вх} = 10 \text{ мА}$ , $U_{обр} = 5 \text{ В}$ )	$K_i$	1		0,5	
Входное напряжение, В (при $I_{вх} = 10 \text{ мА}$ )	$U_{вх}$		1,7		1,7
Время нарастания и время спада выходного сигнала, нс (при $I_{вх.и} = 10 \text{ мА}$ , $U_{обр} = 10 \text{ В}$ )	$t_{нр}$ $t_{сп}$		105		175
Время задержки, нс (при $I_{вх.и} = 10 \text{ мА}$ , $U_{обр} = 10 \text{ В}$ )	$t_{зд}$		50		70
Сопротивление изоляции, Ом (при $U_{из} = 200 \text{ В}$ )	$R_{из}$	$10^{10}$		$10^{10}$	
Проходная емкость, пФ (при $U_{из} = 0 \text{ В}$ )	$C_{пр}$		2		2
Ток утечки на выходе, мкА (при $U_{обр} = 8 \text{ В}$ )	$I_{ут.вых.}$		2		2
Неповторяющееся импульсное напряжение изоляции, В (при $t_{и} \leq I_c$ , скважность $\geq 2$ )	$U_{ис.и.нр}$	400		400	

## СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

Золото 0,6548 г;

в том числе:

золото -  $2,424 \cdot 10^{-3}$  г/мм на 4 выводах длиной 5 мм.

Цветных металлов не содержится

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Оптопары диодные типа АОЛ20 А-1 соответствуют техническим условиям АА0.336.305 ТУ.

ОТК 9

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При монтаже оптопар не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое взаимодействие с защитным покрытием и другими элементами конструкции оптопар.
2. При входном контроле оптопар у потребителя производят измерение электрических параметров без изъятия их из индивидуальной тары.
3. Присоединение гибких выводов оптопар рекомендуется производить методом контактно-импульсной сварки или термокомпрессии на установках типов "Контакт 3А". При монтаже оптопар в микросхему должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла и защитного покрытия оптопары свыше  $130^\circ\text{C}$ . Соединение выводов оптопары с элементами микросхемы производится на расстоянии не менее 0,7 мм от кристалла. Крепление оптопары должно обеспечивать фиксированное положение как самой оптопары, так и ее выводов. Запрещается крепить оптопару за гибкие выводы. При монтаже должны быть исключены перекрещивание и перекручивание выводов, соприкосновения выводов с кристаллами, растяжение, сдвиг выводов.
4. Допустимое значение статического потенциала 30 В.